

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT ZGM / ZGE  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

07. MRZ 2001

Eingang

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

**PCT**

An  
ROBERT BOSCH GMBH  
Postfach 30 02 20  
D-70442 Stuttgart  
GERMANY

Frist	Nr.
07.05.2001	129428
Bearb. Eing.	vorl. Abt.
	08/03/01
Bearb. erl.	
gelöscht	

Frist	Nr.
27.07.2001	12259820M
Bearb. Eing.	vorl. Abt.
Bearb. erl.	
gelöscht	

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES  
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS  
ODER DER ERKLÄRUNG

(Regel 44.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr)

07/03/2001

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

R. 36937 Kut/Hx

**WEITERES VORGEHEN**

siehe Punkte 1 und 4 unten

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/03545

Internationales Anmeldedatum  
(Tag/Monat/Jahr)

10/10/2000

Anmelder

ROBERT BOSCH GMBH et al.

1.  Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit übermittelt wird.

**Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19:**

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46):

**Bis wann sind Änderungen einzureichen?**

Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.

**Wo sind Änderungen einzureichen?**

Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Genf 20,  
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35

Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.

2.  Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17(2)a übermittelt wird.

3.  **Hinsichtlich des Widerspruchs** gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmelder mitgeteilt, daß

der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungssämter dem Internationalen Büro übermittelt worden sind.

noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde.

4. **Weiteres Vorgehen:** Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht:

Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffentlicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 bis 90 bis 3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen.

Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch länger) verschieben möchte.

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum muß der Anmelder die für den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen Handlungen vor allen Bestimmungssämtern vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum in der Anmeldung oder einer nachträglichen Auswahlerklärung ausgewählt wurden oder nicht ausgewählt werden konnten, da für sie Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
  
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL-2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter  
 Trudy Thoen-de Jong

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

## ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsitzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutern sind:

1. [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:  
"Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt."
2. [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]:  
"Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]:  
"Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]:  
"Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Anspruch 14 ersetzt; Anspruch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

### "Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

### Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf internationale vorläufige Prüfung

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internationalen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

### Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung der internationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordernisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

## ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu entnehmen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

### HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

#### Welche Teile der internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

#### Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

#### Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

#### In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen, so brauchen die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht wird.

#### Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

##### Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

**VERTRAG FÜR DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS**

**PCT**

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  R. 36937 Kut/Hx	<b>WEITERES VORGEHEN</b>	siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5
Internationales Aktenzeichen  PCT/DE 00/03545	Internationales Anmelddatum (Tag/Monat/Jahr)  10/10/2000	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  27/11/1999
Anmelder  ROBERT BOSCH GMBH et al.		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

**1. Grundlage des Berichts**

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

in der internationalen Anmeldung in Schriftlicher Form enthalten ist.

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2.  Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3.  Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

**4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung**

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

**5. Hinsichtlich der Zusammenfassung**

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

**6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 1**

wie vom Anmelder vorgeschlagen  keine der Abb.

weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/03545

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 H01L21/3065 H01J37/32

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 H01L H01J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal, INSPEC

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie <sup>a</sup>	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 01, 30. Januar 1998 (1998-01-30) -& JP 09 232738 A (NISSIN ELECTRIC CO LTD), 5. September 1997 (1997-09-05) <i>Zusammenfassung, Abbildung 2 Abstract, Drawing 2</i> ---	1-6, 8, 10-13
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 03, 28. April 1995 (1995-04-28) -& JP 06 342770 A (NISSIN ELECTRIC CO LTD), 13. Dezember 1994 (1994-12-13) <i>Zusammenfassung Abstract</i> <i>Absätze 0019!, 0020!, Abbildungen 1,3 Paragraphs 19, 20; Drawings 1,3</i> ---	1-5, 10, 12, 13



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

- <sup>a</sup> Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- \*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- \*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- \*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- \*&\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

28. Februar 2001

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

07/03/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Szarowski, A

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/03545

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 08, 30. Juni 1998 (1998-06-30) -& JP 10 074730 A (HITACHI LTD), 17. März 1998 (1998-03-17) <u>Zusammenfassung</u> <i>Abstract</i> <u>Absätze</u> '0011!, '0020!; <u>Abbildungen</u> 1,4 <u>Paragraphs</u> 11, 20; <u>Drawings</u> 1,4	

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

•Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/03545

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 09232738 A	05-09-1997	KEINE	
JP 06342770 A	13-12-1994	JP 2974512 B	10-11-1999
JP 10074730 A	17-03-1998	KEINE	

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  R. 36937 Kut/Hx	<b>WEITERES VORGEHEN</b>  siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen  PCT/DE 00/ 03545	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  10/10/2000	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  27/11/1999
Anmelder  ROBERT BOSCH GMBH et al.		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 3 Blätter.

Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der **Sprache** ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das

in der internationalen Anmeldung in Schriftlicher Form enthalten ist.

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

2.  Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

3.  Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Folgende Abbildung der **Zeichnungen** ist mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 1

wie vom Anmelder vorgeschlagen

weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

keine der Abb.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 H01L21/3065 H01J37/32

#### **Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK**

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchiertes Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )  
**IPK 7 H01L H01J**

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal, INSPEC

#### C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 01, 30. Januar 1998 (1998-01-30) -& JP 09 232738 A (NISSIN ELECTRIC CO LTD), 5. September 1997 (1997-09-05) Zusammenfassung; Abbildung 2 ---	1-6, 8, 10-13
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 03, 28. April 1995 (1995-04-28) -& JP 06 342770 A (NISSIN ELECTRIC CO LTD), 13. Dezember 1994 (1994-12-13) Zusammenfassung Absätze '0019!, '0020!; Abbildungen 1,3 ---	1-5, 10, 12, 13

X

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

1

## **Siehe Anhang Patentfamilie**

- ° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- \*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- \*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- \*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- \*&\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche  <b>28. Februar 2001</b>	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts  <b>07/03/2001</b>
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter  <b>Szarowski, A</b>

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

## INTERNATIONALER FISCHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE 00/03545

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 08, 30. Juni 1998 (1998-06-30) -& JP 10 074730 A (HITACHI LTD), 17. März 1998 (1998-03-17) Zusammenfassung Absätze '0011!, '0020!; Abbildungen 1,4 -----	
1		

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 00/03545

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
JP 09232738 A	05-09-1997	NONE	
JP 06342770 A	13-12-1994	JP 2974512 B	10-11-1999
JP 10074730 A	17-03-1998	NONE	

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

**PCT**  
**ANTRAG**

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird

Vom Anmeldeamt auszufüllen

**Internationales Aktenzeichen**

**Internationales Anmeldedatum**

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (*falls gewünscht*)  
(max. 12 Zeichen) R. 36937 Kut/Hx

**Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG**

Plasmaätzverfahren mit gepulster Substratelektrodenleistung

**Feld Nr. II ANMELDER**

Name und Anschrift (*Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.*)

ROBERT BOSCH GMBH  
Postfach 30 02 20  
70442 Stuttgart  
Bundesrepublik Deutschland (DE)

Diese Person ist gleichzeitig Erfinder

Telefonnr.:  
0711/811-23 062

Telefaxnr.:  
0711/811-33 1 81

Fernschreibnr.:

Staatsangehörigkeit (Staat): DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE

Diese Person ist Anmelder  alle Bestimmungsstaaten  alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten  nur die Vereinigten Staaten von Amerika  die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

**Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER**

Name und Anschrift (*Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.*)

LAERMER, Franz  
Hermann-Schütz-Str. 22  
71263 Weil der Stadt  
DE

Diese Person ist nur Anmelder

Anmelder und Erfinder

nur Erfinder (*Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.*)

Staatsangehörigkeit (Staat): DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE

Diese Person ist Anmelder  alle Bestimmungsstaaten  alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten  nur die Vereinigten Staaten von Amerika  die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.

**Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT**

Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als:

Anwalt  gemeinsamer Vertreter

Name und Anschrift (*Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben*)

Telefonnr.:

Telefaxnr.:

Fernschreibnr.:

Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.



## Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER

Wird keines der folgenden Felder benutzt, so ist dieses Blatt dem Antrag nicht beizufügen.

Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

SCHILP, Andrea  
Seelenbachweg 15  
73525 Schwaebisch Gmuend  
DE

Diese Person ist

 nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Staatsangehörigkeit (Staat): DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE

Diese Person ist Anmelder  alle Bestimmungsstaaten  alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten  nur die Vereinigten Staaten von Amerika  die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Diese Person ist

 nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Staatsangehörigkeit (Staat):

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

Diese Person ist Anmelder  alle Bestimmungsstaaten  alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten  nur die Vereinigten Staaten von Amerika  die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Diese Person ist

 nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Staatsangehörigkeit (Staat):

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

Diese Person ist Anmelder  alle Bestimmungsstaaten  alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten  nur die Vereinigten Staaten von Amerika  die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Diese Person ist

 nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Staatsangehörigkeit (Staat):

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

Diese Person ist Anmelder  alle Bestimmungsstaaten  alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten  nur die Vereinigten Staaten von Amerika  die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

 Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.



## Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN

Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen:

## Regionales Patent

AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swasiland, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist

EA Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist

EP Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist

OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist

Nationales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):

<input type="checkbox"/> AE Vereinigte Arabische Emirate	<input type="checkbox"/> LR Liberia
<input type="checkbox"/> AL Albanien	<input type="checkbox"/> LS Lesotho
<input type="checkbox"/> AM Armenien	<input type="checkbox"/> LT Litauen
<input type="checkbox"/> AT Österreich	<input type="checkbox"/> LU Luxemburg
<input type="checkbox"/> AU Australien	<input type="checkbox"/> LV Lettland
<input type="checkbox"/> AZ Aserbaidschan	<input type="checkbox"/> MD Republik Moldau
<input type="checkbox"/> BA Bosnien-Herzegowina	<input type="checkbox"/> MG Madagaskar
<input type="checkbox"/> BB Barbados	<input type="checkbox"/> MK Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
<input type="checkbox"/> BG Bulgarien	<input type="checkbox"/> MN Mongolei
<input type="checkbox"/> BR Brasilien	<input type="checkbox"/> MW Malawi
<input type="checkbox"/> BY Belarus	<input type="checkbox"/> MX Mexiko
<input type="checkbox"/> CA Kanada	<input type="checkbox"/> NO Norwegen
<input type="checkbox"/> CH und LI Schweiz und Liechtenstein	<input type="checkbox"/> NZ Neuseeland
<input type="checkbox"/> CN China	<input type="checkbox"/> PL Polen
<input type="checkbox"/> CU Kuba	<input type="checkbox"/> PT Portugal
<input type="checkbox"/> CZ Tschechische Republik	<input type="checkbox"/> RO Rumänien
<input type="checkbox"/> DE Deutschland	<input type="checkbox"/> RU Russische Föderation
<input type="checkbox"/> DK Dänemark	<input type="checkbox"/> SD Sudan
<input type="checkbox"/> EE Estland	<input type="checkbox"/> SE Schweden
<input type="checkbox"/> ES Spanien	<input type="checkbox"/> SG Singapur
<input type="checkbox"/> FI Finnland	<input type="checkbox"/> SI Slowenien
<input type="checkbox"/> GB Vereinigtes Königreich	<input type="checkbox"/> SK Slowakei
<input type="checkbox"/> GD Grenada	<input type="checkbox"/> SL Sierra Leone
<input type="checkbox"/> GE Georgien	<input type="checkbox"/> TJ Tadschikistan
<input type="checkbox"/> GH Ghana	<input type="checkbox"/> TM Turkmenistan
<input type="checkbox"/> GM Gambia	<input type="checkbox"/> TR Türkei
<input type="checkbox"/> HR Kroatien	<input type="checkbox"/> TT Trinidad und Tobago
<input type="checkbox"/> HU Ungarn	<input type="checkbox"/> UA Ukraine
<input type="checkbox"/> ID Indonesien	<input type="checkbox"/> UG Uganda
<input type="checkbox"/> IL Israel	<input type="checkbox"/> US Vereinigte Staaten von Amerika
<input type="checkbox"/> IN Indien	<input type="checkbox"/> UZ Usbekistan
<input type="checkbox"/> IS Island	<input type="checkbox"/> VN Vietnam
<input checked="" type="checkbox"/> JP Japan	<input type="checkbox"/> YU Jugoslawien
<input type="checkbox"/> KE Kenia	<input type="checkbox"/> ZA Südafrika
<input type="checkbox"/> KG Kirgisistan	<input type="checkbox"/> ZW Simbabwe
<input type="checkbox"/> KP Demokratische Volksrepublik Korea	
<input checked="" type="checkbox"/> KR Republik Korea	
<input type="checkbox"/> KZ Kasachstan	
<input type="checkbox"/> LC Saint Lucia	
<input type="checkbox"/> LK Sri Lanka	

Kästchen für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind:

.....

.....

Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

Feld Nr. VI PRIORITYANSPRÜCHE		Weitere Prioritätsansprüche sind im Zusatzfeld angegeben		
Anmeldedatum der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	Aktenzeichen der früheren Anmeldung	Ist die frühere Anmeldung eine:		
		nationale Anmeldung: Staat	regionale Anmeldung: * regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt
Zeile (1) 27. November 1999 27.11.99	199 57 169.4	Bundesrepublik Deutschland		
Zeile (2)				
Zeile (3)				

Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in Zeile(n) (1) bezeichneten früheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem Internationalen Büro zu übermitteln.

#### Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

Wahl der Internationalen Recherchenbehörde (ISA)  
(falls zwei oder mehr als zwei Internationale Recherchenbehörden für die Ausführung der internationalen Recherche zuständig sind, geben Sie die von Ihnen gewählte Behörde an: (der: Zweibuchstaben-Code kann bemitzt werden))  
ISA/

Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer früheren Recherche: Bezugnahme auf diese frühere Recherche (falls eine frühere Recherche bei der internationalen Recherchenbehörde beantragt oder von ihr durchgeführt worden ist):  
Datum (Tag/Monat/Jahr): Aktenzeichen Staat (oder regionales Amt)

#### Feld Nr. VIII KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE

Diese internationale Anmeldung enthält die folgende Anzahl von Blättern:

Antrag : 4 Blätter

Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) : 16 Blätter

Ansprüche : 3 Blätter

Zusammenfassung: 1 Blätter

Zeichnungen : 3 Blätter

Sequenzprotokollteil der Beschreibung : Blätter

Blattzahl insgesamt : 27 Blätter

Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei:

- 1.  Blatt für die Gebührenberechnung
- 2.  Gesonderte unterzeichnete Vollmacht
- 3.  Kopien der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden)
- 4.  Begründung für das Fehlen einer Unterschrift
- 5.  Prioritätsbeleg(e), in Feld VI durch folgende Zeilennummer gekennzeichnet:
- 6.  Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache:
- 7.  Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder biologischem Material
- 8.  Sequenzprotokolle für Nucleotide und/oder Aminosäuren (Diskette)
- 9.  Sonstige (einzel aufführen):  
Abschrift für Prioritätsbeleg

Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.): 1

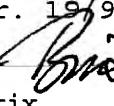
Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht wird: Deutsch

#### Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS

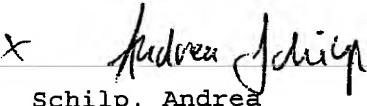
Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet.

ROBERT BOSCH GMBH

Nr. 1995 AV

  
Brix

Laermer, Franz

  
Schilp, Andrea

Vom Anmeldeamt auszufüllen		2. Zeichnungen
1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung	3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:	
4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellung nach Artikel 11(2) PCT:		
5. Vom Anmelder benannte Internationale Recherchenbehörde: ISA/	6. <input type="checkbox"/> Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchengebühr aufgeschoben	

Vom Internationalen Büro auszufüllen	
Datum des Eingangs des Aktenexemplars beim Internationalen Büro:	

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG



(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
31. Mai 2001 (31.05.2001)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 01/39261 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01L 21/3065, H01J 37/32**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE00/03545**

(22) Internationales Anmeldedatum:  
10. Oktober 2000 (10.10.2000)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:  
199 57 169.4 27. November 1999 (27.11.1999) **DE**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).**

(72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **LAERMER, Franz [DE/DE]; Hermann-Schütz-Strasse 22, 71263 Weil der Stadt (DE). SCHILP, Andrea [DE/DE]; Seelenbachweg 15, 73525 Schwaebisch Gmuend (DE).**

(81) Bestimmungsstaaten (national): **JP, KR, US.**

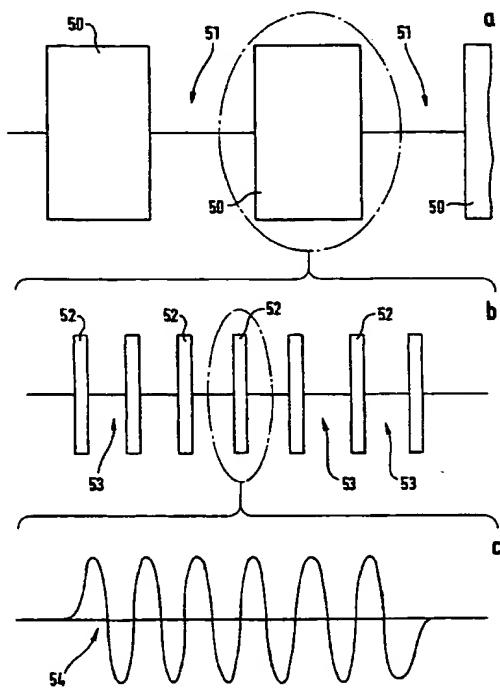
(84) Bestimmungsstaaten (regional): **europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).**

**Veröffentlicht:**  
— *Mit internationalem Recherchenbericht.*

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: **METHOD FOR PLASMA ETCHING WITH PULSED SUBSTRATE ELECTRODE POWER**

(54) Bezeichnung: **PLASMAÄTZVERFAHREN MIT GEPUЛЬSTER SUBSTRATELEKTRODENLEISTUNG**



(57) **Abstract:** A method for etching structures in an etching substrate (18), in particular in a silicon body (18) by means of a plasma (14) with a lateral extent, which is exactly defined by means of an etching mask, is disclosed. A high frequency pulsed high frequency power is coupled with the etching substrate (18) by means of an, at least temporarily applied, high frequency alternating voltage. Said coupled high frequency pulsed high frequency power is furthermore modulated with a low frequency and, in particular, cycled. Said disclosed method opens a wide process window, for the variation of etching parameters in the plasma etching process as carried out and is particularly suitable for the etching of structures in silicon, with high mask selectivity and high etching rates, with simultaneously minimised charging effects, in particular with regard to pocket formation on dielectric boundary surfaces.

(57) **Zusammenfassung:** Es wird ein Verfahren zum Ätzen von Strukturen in einem Ätzkörper (18), insbesondere von mit einer Ätzmaske lateral exakt definierten Ausnehmungen in einem Siliziumkörper (18), mittels eines Plasmas (14) vorgeschlagen. Dabei wird über eine zumindest zeitweilig anliegende hochfrequente Wechselspannung in den Ätzkörper (18) zumindest zeitweilig eine hochfrequent gepulste Hochfrequenzleistung eingekoppelt. Diese eingekoppelte, hochfrequent gepulste Hochfrequenzleistung wird weiter niederfrequent moduliert, insbesondere getaktet. Das vorgeschlagene Verfahren eröffnet ein weiteres Prozessfenster zur Variation von Ätzparametern bei dem durchgeführten Plasmaätzprozess, und eignet sich besonders zur Ätzung von Strukturen in Silizium mit hoher Maskenselektivität und hohen Ätzraten bei gleichzeitig minimierten Aufladungseffekten, insbesondere hinsichtlich einer Taschenbildung an dielektrischen Grenzflächen.

**WO 01/39261 A1**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

10 Plasmaätzverfahren mit gepulster Substratelektrodenleistung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ätzen von Strukturen in einem Ätzkörper mittels eines Plasmas, nach der Gattung des Hauptanspruches.

15

Stand der Technik

Anisotrope Plasmaätzverfahren sind beispielsweise aus DE 197 06 682 A1 oder DE 42 41 045 C2 bekannt, in denen jeweils 20 über eine hochdichte Plasmaquelle ein Plasma aus neutralen Radikalen und elektrisch geladenen Teilchen erzeugt wird, die durch eine Biasspannungsquelle zu einer Substratelektrode, die den zu prozessierenden Wafer trägt, hin beschleunigt werden. Durch die Vorzugsrichtung der 25 einfallenden Ionen kommt dabei ein gerichteter Ätzprozeß zustande.

Als Biasspannungsquelle, die die elektrische Spannung zur 30 Beschleunigung der Ionen aus dem Plasma zur Substratelektrode erzeugt, werden weiter üblicherweise Hochfrequenzgeneratoren mit einer Träger-Frequenz von 13,56 MHz verwendet. Dabei wird der Hochfrequenzgenerator jeweils durch ein LC-Netzwerk ("Matchbox") an die Impedanz der

Substratelektrode und des Plasmas, das in Kontakt mit der Substratelektrode steht, angepaßt.

5 Mit Rücksicht auf eine gute Maskenselektivität, das ist das Verhältnis der Siliziumätzrate zur Ätzgeschwindigkeit der Maskierschicht, ist weiter bereits bekannt, die Hochfrequenzleistung an der Substratelektrode relativ niedrig zu wählen, um den ionenunterstützten Maskenabtrag möglichst gering zu halten. Übliche Leistungswerte liegen 10 zwischen 5 Watt und 20 Watt, so daß die Energie der auf die Substratoberfläche einfallenden Ionen typischerweise einige 10 eV beträgt.

15 Derart niedrige Ionenenergien sind zwar hinsichtlich der Maskenselektivität vorteilhaft, sie führen jedoch auch dazu, daß die einfallenden Ionen in ihrer Richtung relativ stark streuen und teilweise vom gewünschten senkrechten Einfall abweichen oder leicht abgelenkt werden können, d.h. ihre 20 Direktionalität ist gering. Derartige Abweichungen der Direktionalität der einfallenden Ionen korrelieren dann mit einer erschwerten Profilkontrolle der erzeugten Ätzprofile. Unter dem Aspekt der Direktionalität des Ionenstroms wäre daher eine hohe Ionenbeschleunigung, also hohe Ionenenergie, 25 wünschenswert, was aber mit der geforderten Maskenselektivität kollidiert.

30 Weiter kommt es beim Einsatz hochdichter Plasmen mit niedrigerenergetischer Ioneneinwirkung auf einem Substrat beim Auftreffen auf einen Ätzstop aus Dielektrika (vergrabene Oxide, Lacksschichten, usw.) vielfach zu Aufladungseffekten an der Grenzschicht Silizium-Dielektrikum. Daraus

resultierende Profilstörungen in Silizium bezeichnet man als Taschenbildung („Notching“) am dielektrischen Interface.

5 Gleichzeitig wächst mit abnehmender Ionenenergie auch die Gefahr der sogenannten „Grasbildung“ auf dem Ätzgrund, d.h. das Prozeßfenster für einen sicheren Ätzprozeß ohne Grasbildung ist limitiert. Unter „Grasbildung“ versteht man dabei eine ungleichmäßige Ätzung des Ätzgrundes unter Ausbildung von einer Vielzahl von eng benachbarten Spitzen,

10 die die Form eines Rasens annehmen.

In den Anmeldungen DE 199 33 842.6 und DE 199 19 832.2 wurde zur Lösung dieser Probleme bereits vorgeschlagen, die hochfrequente Wechselspannung, die zur

15 Substratbiaserzeugung, d.h. zur Erzeugung der in das zu ätzende Substrat einzukoppelnden Substratelektrodenleistung, verwendet wird, zu pulsen, und gleichzeitig die Ionenenergie während der Hochfrequenzimpulse höher zu wählen als bei einem Dauerstrichbetrieb.

20 Bei diesem Pulsbetrieb wird jedoch beobachtet, daß eine wirksame Unterdrückung der Taschenbildung erst bei relativ langen Pausenzeiten von 0,1 ms bis 1 ms zwischen den angelegten Hochfrequenzimpulsen erreicht wird. Werden die Impulspausen unter 0,1 ms verkürzt, tritt in zunehmendem Maße

25 erneut Taschenbildung auf, die auch durch eine Steigerung der Impulsspitzenleistung und eine korrespondierende Verkürzung der Impulsdauer nicht mehr unterdrückt werden kann.

30 Für lange Pausenzeiten von 0,1 ms bis 1 ms verengt sich überdies das Prozeßfenster für einen sicheren Prozeß, d.h.

5 einen grasfreien Ätzgrund, bei Verkürzung der Pulszeit mit entsprechender Steigerung der Impulsspitzenleistung, d.h. der Ätzprozeß wird zwar immer taschenstabiler, die Unterdrückung eines grasfreien Ätzgrundes wird jedoch immer geringer. Die Forderung eines „taschenstabilen“ Prozesses steht somit bisher im Widerspruch zu einem „grasstabilen“ Prozeß.

10 Unter dem Prozeßfenster versteht man dabei die für die Durchführung eines in der erläuterten Weise sicheren Ätzprozesses geeigneten Prozeßparameterbereiche, insbesondere hinsichtlich Prozeßdruck, Substratelektrodenleistung, Plasmaleistung und Gasflüsse sowie gegebenenfalls der Taktzeiten für alternierende Ätz- und Passivierzyklen.

15 Insgesamt sind bei den bekannten Verfahren somit unter den Randbedingungen einer ausreichenden Unterdrückung der „Taschenbildung“ und eines "grasfreien" Ätzgrundes die einsetzbaren Hochfrequenzimpulsspitzenleistungen und damit die Ionenenergien, also die Direktonalität des Ioneneinfalls, begrenzt, so daß bisher eine unerwünschte Einengung des Prozeßfensters, d.h. der verwendbaren Prozeßparameter, eintritt.

25 Besonders störend wirkt sich diese Einengung des Prozeßfensters aufgrund der Grasbildung dann aus, wenn Hochratenätzprozesse durchgeführt werden sollen, da damit der Bereich der zulässigen Prozeßdrücke nach oben begrenzt ist. Andererseits sind gerade hohe Drücke, hohe Gasflüsse und hohe Plasmaleistungen an der induktiven Quelle vorteilhaft zur Erreichung hoher Ätzraten.

### Vorteil der Erfindung

Das erfindungsgemäße Plasmaätzverfahren hat gegenüber dem Stand der Technik den Vorteil, daß damit die Puls- und Pausenzeiten der eingekoppelten, hochfrequent gepulsten Hochfrequenzleistung deutlich verkürzt werden können, und damit ein Pulsbetrieb mit hoher Repetitionsrate im 100 kHz-Bereich darstellbar ist.

Entsprechend dem Puls-zu-Pause-Verhältnis kann bei dieser hohen Wiederholfrequenz weiter vorteilhaft nunmehr auch die Impulsspitzenleistung umgekehrt proportional dazu erhöht bzw. hochskaliert werden.

Gleichzeitig wird neben der effektiven Unterdrückung der Taschenbildung (Notching-Effekte) ein sehr stabiler und robuster Prozeß erreicht, der bei Variation der Prozeßparameter innerhalb eines weiten Prozeßfensters nicht zur Bildung von „Gras“ am Ätzgrund neigt.

Weiter können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren nunmehr sehr hohe Hochfrequenzspitzenleistungen bei entsprechend kurzer Pulsdauer, d.h. entsprechend kleinem Puls-zu-Pause- bzw. Impuls-zu-Periode-Verhältnis, eingesetzt werden. Damit ergibt sich vorteilhaft eine entsprechend hohe Ionenergie von typischerweise 50 eV bis 1000 eV, was mit einer sehr guten Direktionalität des Ioneneinfalls verbunden ist.

Dabei nutzt man aus, daß beim Einsatz kurzer Pulse mit hoher Wiederholrate die zeitliche Mittelung der Leistungswerte über eine dichte Folge von Kurzzeitpulsen erfolgt, von denen jeder einzelne nur einen relativ geringen Energieeintrag auf

den Ätzkörper darstellt. Dies führt insgesamt zu einer hohen Prozeßstabilität.

5 Im Gegensatz zu relativ langen Pulsen mit relativ langen Pausen, bei denen die Energie in einem Einzelimpuls bereits so groß ist, daß während eines Einzelimpulses Störeffekte in der Elektroden-Plasma-Wechselwirkung auftreten, wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorteilhaft weiter nicht mehr beobachtet, daß bei Verkürzung der Pulsdauern und  
10 entsprechender Erhöhung der Impulsspitzenleistung eine Erhöhung der bei der Ätzung benötigten mittleren eingetragenen Leistung in die Substratelektrode bzw. den Ätzkörper erforderlich ist. Vielmehr skalieren nun Puls-zu-Periode-Verhältnis und benötigte Impulsspitzenleistung recht  
15 gut umgekehrt proportional.

20 Insgesamt werden durch die hochfrequente Pulsung der Hochfrequenzleistungspulse Störeffekte in der Plasma-Substratelektrodenwechselwirkung wirksam unterdrückt, so daß bei gegebener Frequenz des Hochfrequenzgenerators, beispielsweise 13,56 MHz, und gegebener, mittlerer, in den Ätzkörper eingekoppelter Hochfrequenzleistung die Ionenenergie und entsprechend der mittlere Ionenstrom auf  
25 den Ätzkörper frei gewählt werden kann.

Wenn man mit  $P$  die mittlere, in den Ätzkörper eingekoppelte Hochfrequenzleistung, die für einen bestimmten Ätzprozeß konstant gehalten werden soll, mit  $p$  die Pulsspitzenleistung bzw. Amplitude der Hochfrequenzleistung in einem Puls, mit  $d$  das Puls-zu-Periode-Verhältnis („Duty Cycle“), mit  $u$  die Ionenbeschleunigungsspannung entsprechend der Energie der auf den Ätzkörper auftreffenden Ionen, mit  $i$  den gepulsten  
30

Ionenstrom, und mit  $I$  den zeitlichen Mittelwert des Ionenstroms bezeichnet, gilt daher bei dem erfindungsgemäßen Prozeß nunmehr:

$$5 \quad p = \frac{P}{d} \quad u = \sqrt{X \frac{P}{d}} \propto \sqrt{\frac{1}{d}} \quad i = \sqrt{\frac{1}{X} \frac{P}{d}} \quad I = \sqrt{\frac{1}{X} P d} \propto \sqrt{d}$$

10 Dabei wurde angenommen, daß sich die Plasmaimpedanz  $X$  mit der eingekoppelten Hochfrequenzleistung nur wenig ändert, also das Ohm'sche Gesetz näherungsweise zutrifft. In der Praxis wird sich die Plasmaimpedanz  $X$  mit Erhöhung der eingekoppelten Hochfrequenzleistung aufgrund von Sättigungseffekten des Ionenstroms und begrenzter, verfügbarer Ionendichten im Plasma sogar noch erhöhen und somit den beschriebenen Effekt noch verstärken.

15 Insgesamt führt das erfindungsgemäße Verfahren somit vorteilhaft dazu, daß sich bei verkleinertem Puls-zu-Periode-Verhältnis  $d$  (oder analog einem verkleinerten Puls-zu-Pause-Verhältnis) und entsprechend hochskalierter Impulsspitzenleistung  $p$ , d.h. konstanter mittlerer Leistung  $P$ , für die Energie  $u$  der auf den Wafer auftreffenden Ionen gilt:  $u \propto \sqrt{\frac{1}{d}}$ , während der mittlere Strom  $I$  sich gemäß  $I \propto \sqrt{d}$  verhält.

20 Somit kann nunmehr über den "Duty Cycle-Parameter"  $d$  bei gleichem Leistungseintrag frei gewählt werden, ob eine hohe Ionenenergie mit entsprechend geringem mittleren Ionenstrom oder eine niedrige Ionenenergie mit entsprechend hohem mittleren Ionenstrom eingestellt werden soll. Man hat also 25 einen zusätzlichen Freiheitsgrad des erfindungsgemäßen

Ätzprozesses erhalten, der in seiner Wirkung einer Einstellbarkeit der Plasm impedanz entspricht, und der dazu genutzt werden kann, das Prozeßfenster, beispielsweise für Hochratenätzprozesse, zu erweitern.

5

Das erfindungsgemäße Verfahren hat weiter den wesentlichen Vorteil, daß neben einer hochfrequent gepulsten Hochfrequenzleistung, die der Prozeßstabilität in einem weiten Prozeßfenster und der Unterdrückung von über die 10 Kenngrößen Ionenenergie und mittlerer Ionenstrom steuerbaren Grasbildung dient, und die auch zu hohen Ätzraten führt, mittels der zusätzlichen, niederfrequenten Modulation der hochfrequent gepulsten Hochfrequenzleistung auch die Taschenbildung an dielektrischen Grenzflächen wirksam 15 unterdrückt werden kann.

Diese niederfrequente Modulation beruht auf der Erkenntnis, daß zu einem Abbau von Aufladungseffekten an diesen 20 dielektrischen Grenzflächen relativ lange Zeiten von in der Regel mehr als 0,5 ms erforderlich sind. Daraus resultiert ein Frequenzbereich für die niederfrequente Modulation von 10 Hz bis 10000 Hz, vorzugsweise von 50 Hz bis 1000 Hz.

Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich somit besonders 25 vorteilhaft für einen taschenstabilen Hochratenätzprozeß bei erhöhtem Prozeßdruck von beispielsweise 20  $\mu$ bar bis 300  $\mu$ bar und hoher Plasmaleistung von bis zu 5000 Watt.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus 30 den in den Unteransprüchen genannten Maßnahmen.

5

So ist besonders vorteilhaft, daß auch bei einem kleinen Puls-zu-Pause-Verhältnis von beispielsweise 1:9 bis 1:19 und entsprechend hohen Pulsspitzenleistungen der eingekoppelten Hochfrequenzleistungspulse von 100 Watt bis 200 Watt ein breites Prozeßfenster hinsichtlich der Grasbildungsgefahr erhalten bleibt.

10

Weiter ist vorteilhaft, daß übliche Hochfrequenzgeneratoren so betrieben werden können, daß eine hochfrequente Pulsung der eingekoppelten Hochfrequenzleistung in Form von Rechteckpulsen möglich ist, wobei die Anstiegszeiten der Taktflanken bei einer Trägerfrequenz von 13,56 MHz weniger als 0,3  $\mu$ s aufweisen. Damit kann das erfindungsgemäße Verfahren vorteilhaft mit kommerziell erhältlichen Generatoren durchgeführt werden, die gegebenenfalls lediglich geringfügig modifiziert werden müssen.

15

20

Eine derartig kurze Anstiegszeit der Taktflanken ist erforderlich, um überhaupt eine hochfrequente Leistungspulsung mit einer Frequenz von 10 kHz bis 500 kHz durchführen zu können.

25

30

Für die Impulsspitzenleistung, d.h. die Amplitude der Hochfrequenzleistung während eines eingekoppelten Hochfrequenzleistungspulses können weiter vorteilhaft Leistungen von 30 Watt bis zu 1200 Watt eingesetzt werden.

30

Zur Erzeugung der niederfrequenten Modulation der hochfrequent gepulsten Hochfrequenzleistung stehen weiter vorteilhaft zwei alternative, jeweils einfach zu realisierende Möglichkeiten zur Verfügung.

Einerseits kann der in der Generatoreinheit integrierte, bereits hochfrequent getaktete Hochfrequenzgenerator, beispielsweise über dessen Gate-Eingang, zusätzlich direkt mit einer niederfrequenten Taktung ein- und ausgeschaltet werden.

5

Andererseits besteht auch die Möglichkeit, einen in die Generatoreinheit integrierten hochfrequenten Taktgeber, der das eigentliche Trägersignal des Hochfrequenzgenerators moduliert, und damit die hochfrequente Pulsung der Hochfrequenzleistung bewirkt, mit einem niederfrequenten Taktgeber zu steuern. Auf diese Weise wird der hochfrequente Taktgeber niederfrequent ein- und ausgetastet, was sich entsprechend auch auf die eingekoppelten Hochfrequenzleistungspulse überträgt.

10

15

#### Zeichnungen

Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Die Figuren 1a bis 1c erläutern das Pulsen der in den Ätzkörper eingekoppelten Hochfrequenzleistung, die Figur 2 zeigt eine Prinzipskizze einer Ätzanlage zur Durchführung des Ätzverfahrens, und die Figuren 3a und 3b erläutern zwei alternative Ausführungsformen der Generatoreinheit.

25

#### Ausführungsbeispiele

Die Figur 2 zeigt eine prinzipiell aus DE 42 41 045 C2 oder DE 197 06 682 A1 bekannte Plasmaätzanlage 5 zur Durchführung eines anisotropen Plasmaätzverfahrens. Dazu ist in einer Ätzkammer 10 eine Substratelektrode 12 mit einem darauf

angeordneten Ätzkörper 18 vorgesehen, der im erläuterten Beispiel ein Siliziumwafer ist. Weiter steht die Substratelektrode 12 mit einer Generatoreinheit 30 elektrisch in Verbindung. Außerdem ist ein Resonator 20 vorgesehen, mit dem in der Ätzkammer 10 im Bereich eines Surfatrons 16 ein Plasma 14 erzeugt wird. Das erläuterte Ausführungsbeispiel ist jedoch nicht auf eine derartige Anlagenkonfiguration beschränkt. Insbesondere eignet sich dazu auch eine an sich bekannte ICP-Plasmaquelle („Inductively Coupled Plasma“) oder ECR-Plasmaquelle („Electron Cyclotron Resonance“).

Wesentlich ist stets nur, daß eine hochdichte Plasmaquelle ein Plasma 14 erzeugt, das aus neutralen Radikalen und elektrisch geladenen Teilchen (Ionen) besteht, wobei die Ionen durch eine in die Substratelektrode 12 bzw. darüber in den Ätzkörper 18 eingekoppelte Hochfrequenzleistung zu der Substratelektrode 12 hin beschleunigt werden, die den zu prozessierenden Ätzkörper 18 trägt, und dort annähernd senkrecht auftreffen, so daß durch die Vorzugsrichtung der einfallenden Ionen ein gerichteter Ätzprozeß zustande kommt.

Auf weitere Details der mit Ausnahme der erfindungsgemäßen Ausführung der Generatoreinheit 30 an sich bekannten Ätzanlage 5 wird verzichtet, da diese dem Fachmann bekannt sind.

Die Generatoreinheit 30 weist einen kommerziell erhältlichen Hochfrequenzgenerator 33, einen Hochfrequenztaktgeber 32, einen Niederfrequenztaktgeber 31 und eine sogenannte „Matchbox“ 34, d.h. ein LC-Netzwerk, auf.

Die Matchbox 34 dient dabei in bekannter Weise dazu, den Hochfrequenzgenerator 33 an die Impedanz der Substratelektrode 12 und des Plasmas 14, das in Kontakt mit der Substratelektrode 12 steht, anzupassen.

5

Um eine gute Maskenselektivität (Verhältnis der Ätzrate des Ätzkörpers 18 zu der Ätzgeschwindigkeit einer darauf aufgebrachten Maskierschicht) zu gewährleisten, wird über die Generatoreinheit 30 im zeitlichen Mittel eine Hochfrequenzleistung von 1 Watt bis 30 Watt in die Substratelektrode 12 eingekoppelt.

10

Um die in die Substratelektrode 12 und darüber in den Ätzkörper 18 eingekoppelte, hochfrequent gepulste Hochfrequenzleistung zu erzeugen, ist zunächst vorgesehen, daß der Hochfrequenzgenerator 33 in der Generatoreinheit 30 ein hochfrequentes Trägersignal 54 mit einer Frequenz von bevorzugt 13,56 MHz und einer Leistung von beispielsweise 400 Watt erzeugt. Anstelle der Frequenz des Trägersignals von 13,56 MHz kommen jedoch ebenso Frequenzen von 1 MHz bis 50 MHz in Frage. Die Leistung des Hochfrequenzgenerators 33 kann weiter auch zwischen 30 Watt bis 1200 Watt betragen. Bevorzugt sind Leistungen von 50 Watt bis 500 Watt.

15

20

25

30

In einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung ist gemäß Figur 3a weiter vorgesehen, daß die Generatoreinheit 30 neben dem Hochfrequenzgenerator 33 und der Matchbox 34 einen an sich bekannten Hochfrequenztaktgeber 32 aufweist, der den Hochfrequenzgenerator 33 derart steuert, daß dieser eine hochfrequent gepulste Hochfrequenzleistung erzeugt. Dies wird anhand der Figuren 1c und 1b erläutert.

Im einzelnen ist in Figur 1c das hochfrequente Trägersignal 54 des Hochfrequenzgenerators 33 mit einer Frequenz von beispielsweise 13,56 MHz und einer Spannungsamplitude, die einer Leistung von beispielsweise 400 Watt entspricht, 5 dargestellt. Durch das Pulsen des Hochfrequenzgenerators 33 mit dem Hochfrequenztaktgeber 32 entstehen dann gemäß Figur 1b hochfrequente Pulse 52 auf die jeweils eine hochfrequente Pulspause 53 folgt. Die Taktung des Trägersignals 54 des Hochfrequenzgenerators 33 durch den Hochfrequenztaktgeber 32 10 erfolgt mit einer Frequenz von 10 kHz bis 500 kHz, bevorzugt von 50 kHz bis 200 kHz. Das Puls-zu-Pause-Verhältnis der hochfrequent gepulsten Hochfrequenzleistung gemäß Figur 1b liegt zwischen 1:1 und 1:100. Besonders bevorzugt liegt es zwischen 1:2 und 1:19.

15 Durch das gewählte Puls-zu-Pause-Verhältnis der hochfrequent gepulsten Hochfrequenzleistung wird zunächst, ausgehend von der erzeugten Leistung des Hochfrequenzgenerators 30, eine über Pulse und Pausen zeitlich gemittelte 20 Hochfrequenzleistung von 1 Watt bis 100 Watt erzeugt.

Die Generatoreinheit 30 weist weiter gemäß Figur 3a einen an 25 sich bekannten Niederfrequenztaktgeber 31 auf, der den Hochfrequenztaktgeber 32 periodisch ein- und ausschaltet bzw. taktet. Auf diese Weise wird die hochfrequent gepulste Hochfrequenzleistung gemäß Figur 1b zusätzlich 30 niederfrequent moduliert. Im einzelnen taktet dazu der Niederfrequenztaktgeber 31 den Hochfrequenztaktgeber 32 mit einer Frequenz von 10 Hz bis 10000 Hz. Bevorzugt sind Frequenzen von 50 Hz bis 1000 Hz.

Insgesamt wird somit durch die niederfrequente Taktung bzw. niederfrequente Modulation mit Hilfe des Niederfrequenztaktgebers 31 ein periodisches Abschalten und Einschalten der eingekoppelten, gepulsten Hochfrequenzleistung in die Substratelektrode 12 und darüber in den Ätzkörper 18 bewirkt. Das Puls-zu-Pause-Verhältnis der niederfrequenten Taktung des Niederfrequenztaktgebers 31 gemäß Figur 1a, d.h. das Verhältnis von niederfrequenten Pulsen 50 und niederfrequenten Pulspausen 51, liegt dabei zwischen 4:1 und 1:4. Als besonders vorteilhaft hat sich herausgestellt, wenn das Puls-zu-Pause-Verhältnis der niederfrequenten Taktung zwischen 1:2 und 2:1, beispielsweise bei 1:1 liegt.

Durch die niederfrequente Taktung der hochfrequent gepulsten Hochfrequenzleistung gemäß Figur 1b wird die in den Ätzkörper 18 letztendlich eingekoppelte Hochfrequenzleistung entsprechend dem jeweiligen Puls-zu-Pause-Verhältnis (Figur 1a) reduziert, so daß schließlich in den Ätzkörper 18 eine typische Hochfrequenzleistung zwischen 1 Watt und 30 Watt eingekoppelt wird.

Die hochfrequenten Pulse 52 gemäß Figur 1b haben im übrigen hinsichtlich der Einhüllenden bevorzugt zumindest näherungsweise die Form von Rechteckpulsen, wobei die Anstiegszeit der Taktflanken der Rechteckpulse weniger als 0,3  $\mu$ s beträgt.

Im übrigen ist es ohne weiteres möglich, den Niederfrequenzgeber 31 mit einer nicht dargestellten Anlagensteuerung zu verbinden, und darüber im Laufe des durchgeföhrten Ätzprozesses die mittlere, in den Ätzkörper 18 eingekoppelte Hochfrequenzleistung zu steuern. Dazu

bietet sich besonders das Puls-zu-Pause-Verhältnis der niederkfrequenten Taktung an. Das Puls-zu-Pause-Verhältnis der hochfrequent gepulsten Hochfrequenzleistung gemäß Figur 1b eignet sich besonders zur Prozeßoptimierung hinsichtlich der bereits erläuterten Grasbildung. Genauso ist es natürlich möglich, das Puls-zu-Pause-Verhältnis der niederkfrequenten Taktung festzuhalten, und zur Steuerung der mittleren Leistung die Impulsspitzenleistung des Generators zu regeln.

10

Die Figur 3b erläutert eine zu Figur 3a alternative Ausführungsform der Generatoreinheit 30 zur Erzeugung einer hochfrequent gepulsten Hochfrequenzleistung, die niederkfrequent moduliert ist. Dazu wird gemäß Figur 3b der Hochfrequenzgenerator 33 zunächst analog der Figur 3a mittels eines Hochfrequenztaktgebers 32 hochfrequent getaktet, so daß er eine hochfrequent gepulste Hochfrequenzleistung gemäß Figur 1b erzeugt. Im Unterschied zu Figur 3a ist in Figur 3b jedoch vorgesehen, daß der Niederfrequenztaktgeber 31 nicht den Hochfrequenztaktgeber 32 steuert, sondern direkt mit dem Hochfrequenzgenerator 33 verbunden ist, und diesen zusätzlich direkt taktet. Eine Schaltung gemäß Figur 3b läßt sich besonders einfach dadurch realisieren, daß man den Niederfrequenztaktgeber 31 an den Gate-Eingang üblicher Hochfrequenzgeneratoren 33 anschließt, die zusätzlich hochfrequent getaktet sind, beispielsweise über einen internen Taktgeber oder den externen Taktgeber 32. Die übrigen Verfahrensparameter bei der Durchführung des Ätzverfahrens gemäß Figur 3b entsprechend dem Verfahren gemäß Figur 3a bzw. den Figuren 1a bis 1c.

15

20

25

30

Die Figuren 1a bis 1c erläutern zusammenfassend in der Übersicht noch einmal die in den Ätzkörper 18 eingekoppelte, mit einer niederfrequenten Modulation versehene, hochfrequent gepulste Hochfrequenzleistung. Dazu geht man 5 zunächst von Figur 1c, d.h. dem hochfrequenten Trägersignal 54 des Hochfrequenzgenerators 33 aus. Dieses Trägersignal 54 wird durch den Hochfrequenztaktgeber 32 gemäß Figur 1b in hochfrequente Pulse 52 und hochfrequente Pulspausen 53 unterteilt. Die hochfrequenten Pulse 52 haben dabei 10 idealerweise zumindest näherungsweise die Form von Rechteckpulsen (Einhüllende) und werden durch das Trägersignal 54 gebildet. Die Figur 1a erläutert dann wie mit Hilfe des Niederfrequenztaktgebers 31 eine 15 niederfrequente Taktung bzw. Modulation der in den Ätzkörper 18 eingekoppelten, hochfrequent gepulsten Hochfrequenzleistung vorgenommen wird. Dazu werden eine Vielzahl von hochfrequenten Pulsen 52 bzw. hochfrequenten Pulspausen 53 zu niederfrequenten Pulsen 50 zusammengefaßt, denen dann jeweils eine niederfrequente Pulspause 51 folgt. Die 20 niederfrequenten Pulse 50 weisen als Einhüllende bevorzugt ebenfalls eine Rechteckpulsform auf. Das Signal gemäß Figur 1a wird dann über die Substratelektrode 12 in den Ätzkörper 18 als Hochfrequenzleistung eingekoppelt.

## 10        Ansprüche

1.        Verfahren zum Ätzen von Strukturen in einem Ätzkörper (18), insbesondere von mit einer Ätzmase lateral exakt definierten Ausnehmungen in einem Siliziumkörper, mittels eines Plasmas (14), wobei in den Ätzkörper (18) über eine zumindest zeitweilig anliegende hochfrequente Wechselspannung zumindest zeitweilig eine hochfrequente gepulste Hochfrequenzleistung eingekoppelt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die eingekoppelte, hochfrequent gepulste Hochfrequenzleistung niederfrequent moduliert wird.
2.        Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die hochfrequente Wechselspannung mittels eines Hochfrequenzgenerators (33) bereitgestellt wird, der ein hochfrequentes Trägersignal (54) erzeugt.
3.        Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die hochfrequente gepulste Hochfrequenzleistung mit einer Frequenz von 10 kHz bis 500 kHz, insbesondere 50 kHz bis 200 kHz, gepulst wird.
4.        Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das hochfrequente

Trägersignal (54) eine Frequenz von 1 MHz bis 50 MHz, insbesondere 13,56 MHz, aufweist.

5. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Hochfrequenzgenerator (33) eine Hochfrequenzleistung mit einer Amplitude von 30 Watt bis 1200 Watt, insbesondere 50 Watt bis 500 Watt, erzeugt.

10 6. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die hochfrequent gepulste Hochfrequenzleistung in Form von Rechteckpulsen (52) eingekoppelt wird.

15 7. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Rechteckpulse (52) eine Anstiegszeit der Taktflanken der Rechteckpulse (52) von weniger als 0,3 µs aufweisen.

20 8. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Puls-zu-Pause-Verhältnis (52, 53) der hochfrequent gepulsten Hochfrequenzleistung zwischen 1:1 und 1:100, insbesondere zwischen 1:2 und 1:19, liegt.

25 9. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Folge der hochfrequent gepulsten Leistungspulse (52) und Pulspausen (53) einer mittleren Hochfrequenzleistung von 1 Watt bis 30 100 Watt entspricht.

10. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die eingekoppelte, hochfrequent gepulste Hochfrequenzleistung mit einer niederfrequenten Taktung (50, 51) periodisch moduliert wird.

5

11. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die niederfrequente Taktung (50, 51) oder die niederfrequente Modulation (50, 51) mit einer Frequenz von 10 Hz bis 10000 Hz, insbesondere 10 50 Hz bis 1000 Hz, erfolgt.

10

12. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die niederfrequente Taktung (50, 51) oder die niederfrequente Modulation (50, 51) ein periodischen Abschalten und Einschalten der eingekoppelten gepulsten Hochfrequenzleistung bewirkt.

15

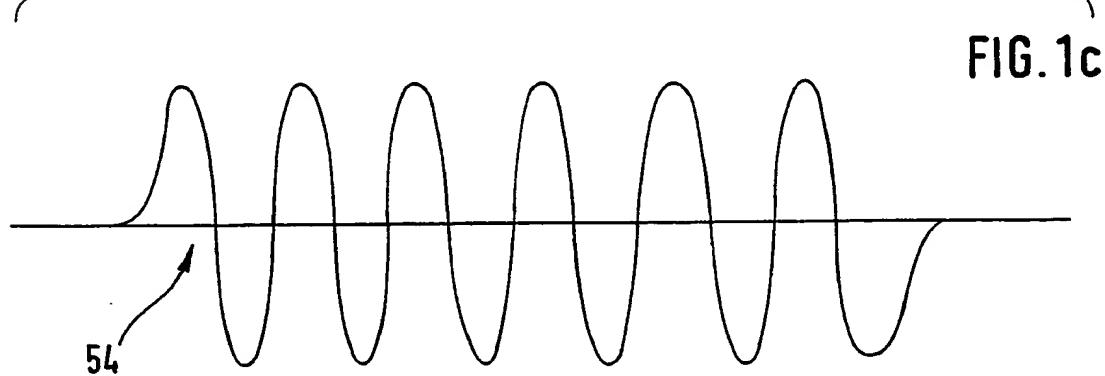
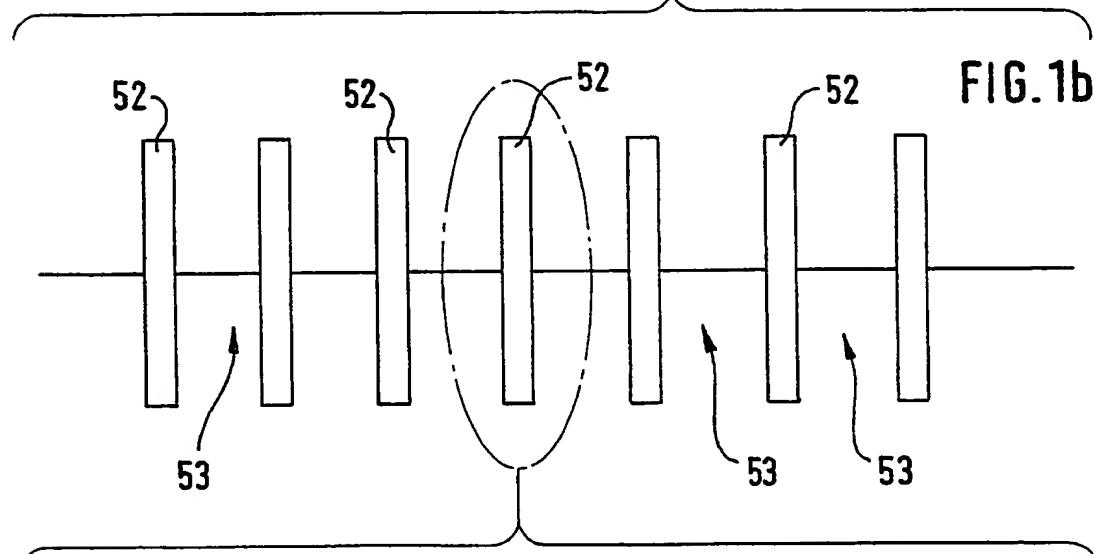
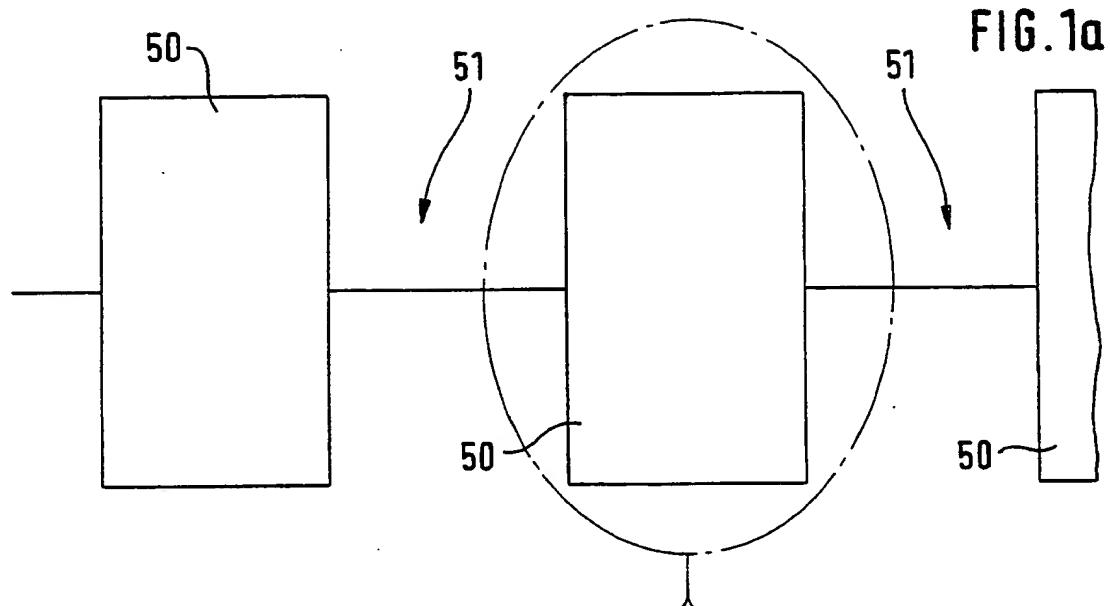
13. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Puls-zu-Pause-20 Verhältnis der niederfrequenten Taktung (50, 51) zwischen 4:1 und 1:4, insbesondere 1:2 und 2:1, liegt.

20

14. Verfahren nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die im zeitlichen 25 Mittel in den Ätzkörper (18) eingekoppelte Hochfrequenzleistung zwischen 1 Watt und 30 Watt liegt.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

1/3



THIS PAGE BLANK (USPTO)

2 / 3

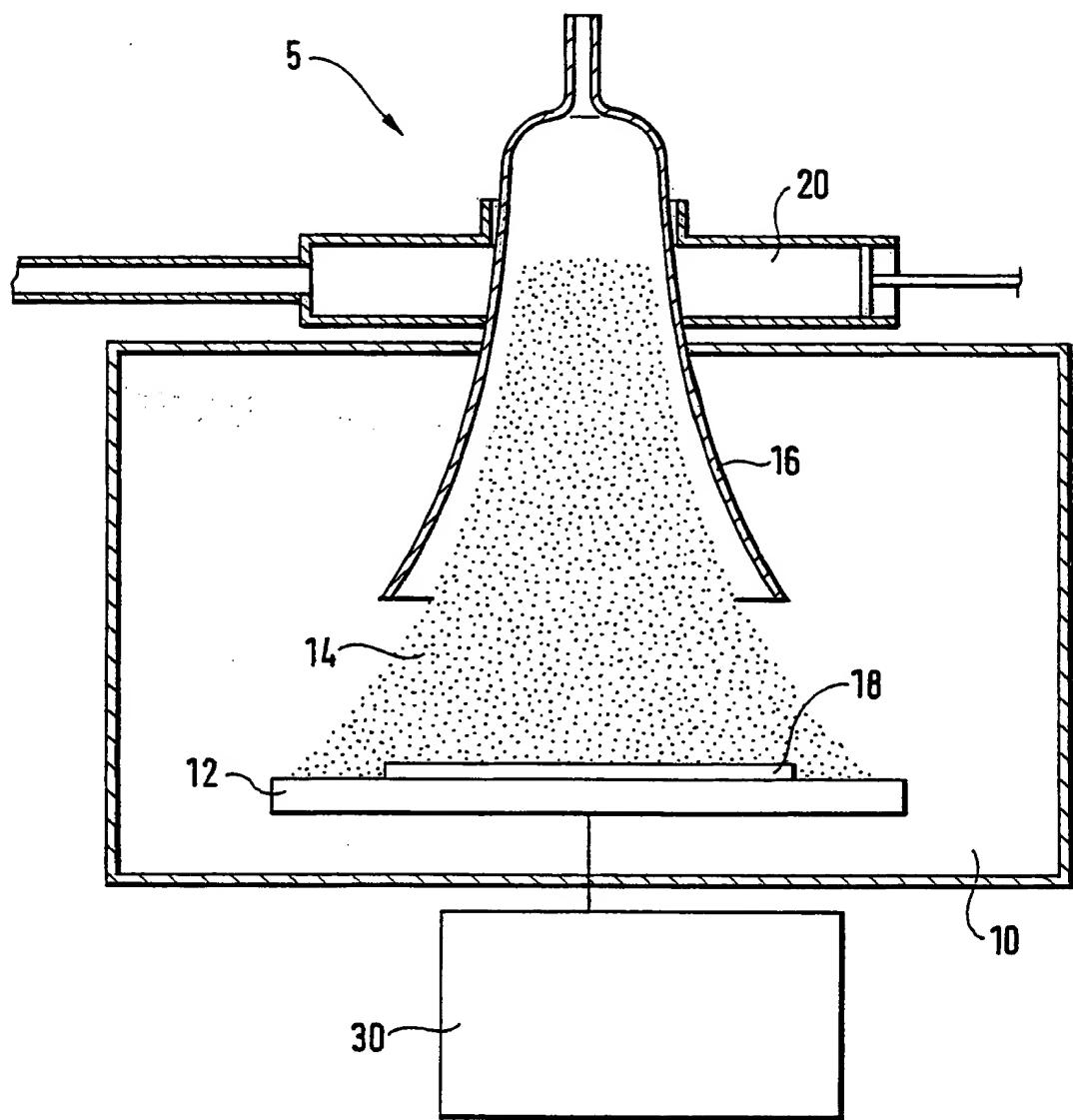


FIG. 2

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

3/3

FIG. 3a

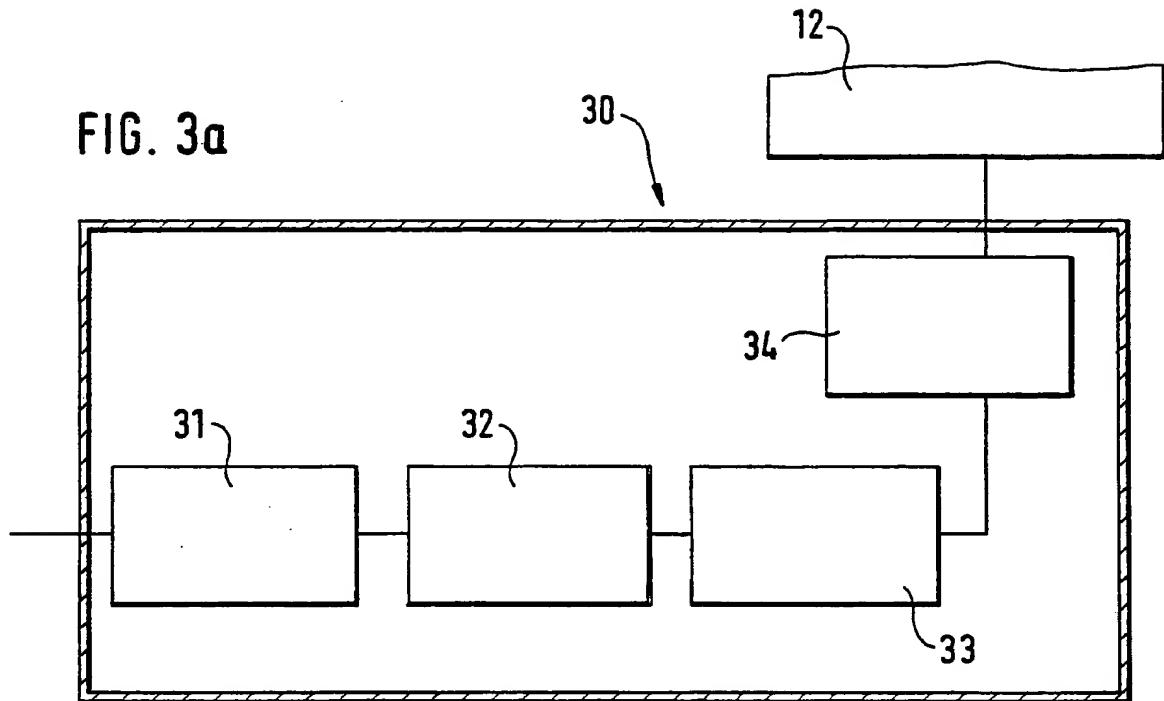
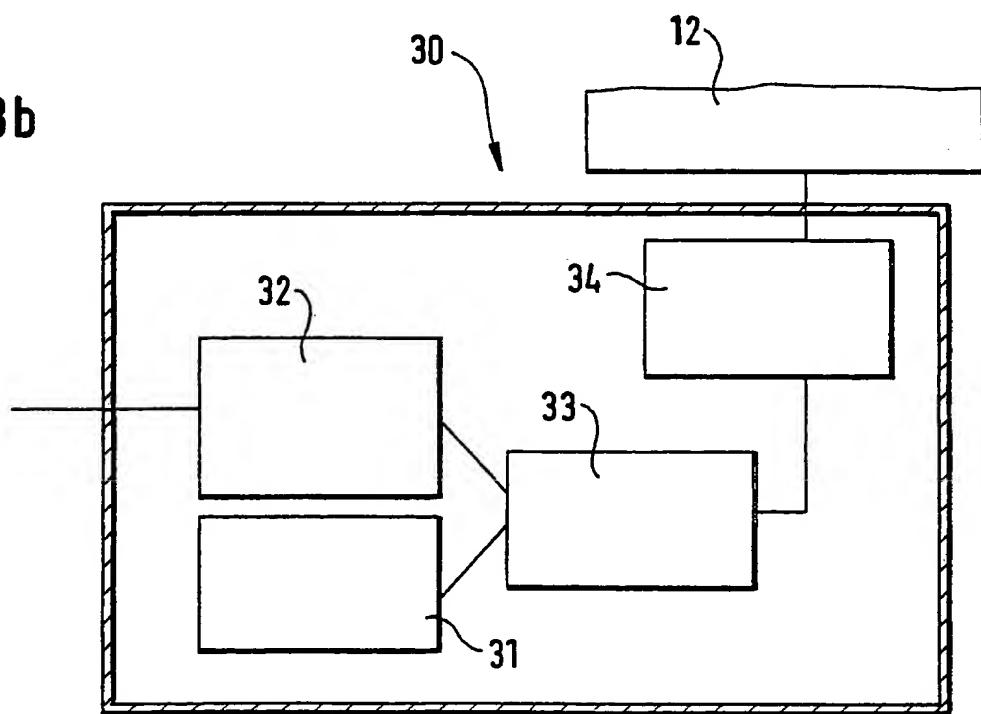


FIG. 3b



THIS PAGE BLANK (USPTO)

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 00/03545

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**

IPC 7 H01L21/3065 H01J37/32

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H01L H01J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal, INSPEC

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 01, 30 January 1998 (1998-01-30) -&amp; JP 09 232738 A (NISSIN ELECTRIC CO LTD), 5 September 1997 (1997-09-05) abstract; figure 2 ---</p>	1-6, 8, 10-13
X	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 03, 28 April 1995 (1995-04-28) -&amp; JP 06 342770 A (NISSIN ELECTRIC CO LTD), 13 December 1994 (1994-12-13) abstract paragraphs '0019!, '0020!; figures 1,3 ---</p>	1-5, 10, 12, 13



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

- °A° document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- °E° earlier document but published on or after the international filing date
- °L° document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- °O° document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- °P° document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

°T° later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

°X° document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

°Y° document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

°Z° document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

28 February 2001

Date of mailing of the international search report

07/03/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Szarowski, A

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int'l Application No  
PCT/DE 00/03545

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 08, 30 June 1998 (1998-06-30) -& JP 10 074730 A (HITACHI LTD), 17 March 1998 (1998-03-17) abstract paragraphs '0011!, '0020!; figures 1,4 -----	

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

Information on patent family members

Int. ~~ional~~ Application No

PCT/DE 00/03545

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
JP 09232738 A	05-09-1997	NONE	
JP 06342770 A	13-12-1994	JP 2974512 B	10-11-1999
JP 10074730 A	17-03-1998	NONE	

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/03545

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 H01L21/3065 H01J37/32

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )  
IPK 7 H01L H01J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal, INSPEC

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 01, 30. Januar 1998 (1998-01-30) -& JP 09 232738 A (NISSIN ELECTRIC CO LTD), 5. September 1997 (1997-09-05) Zusammenfassung; Abbildung 2 ---	1-6,8, 10-13
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 03, 28. April 1995 (1995-04-28) -& JP 06 342770 A (NISSIN ELECTRIC CO LTD), 13. Dezember 1994 (1994-12-13) Zusammenfassung Absätze '0019!, '0020!; Abbildungen 1,3 ---	1-5,10, 12,13

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- \* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- \*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- \*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- \*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- \*&\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

28. Februar 2001

07/03/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Szarowski, A

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/03545

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 08, 30. Juni 1998 (1998-06-30) -&amp; JP 10 074730 A (HITACHI LTD), 17. März 1998 (1998-03-17) Zusammenfassung Absätze '0011!, '0020!; Abbildungen 1,4</p> <p>-----</p>	

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/03545

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 09232738 A	05-09-1997	KEINE	
JP 06342770 A	13-12-1994	JP 2974512 B	10-11-1999
JP 10074730 A	17-03-1998	KEINE	

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**